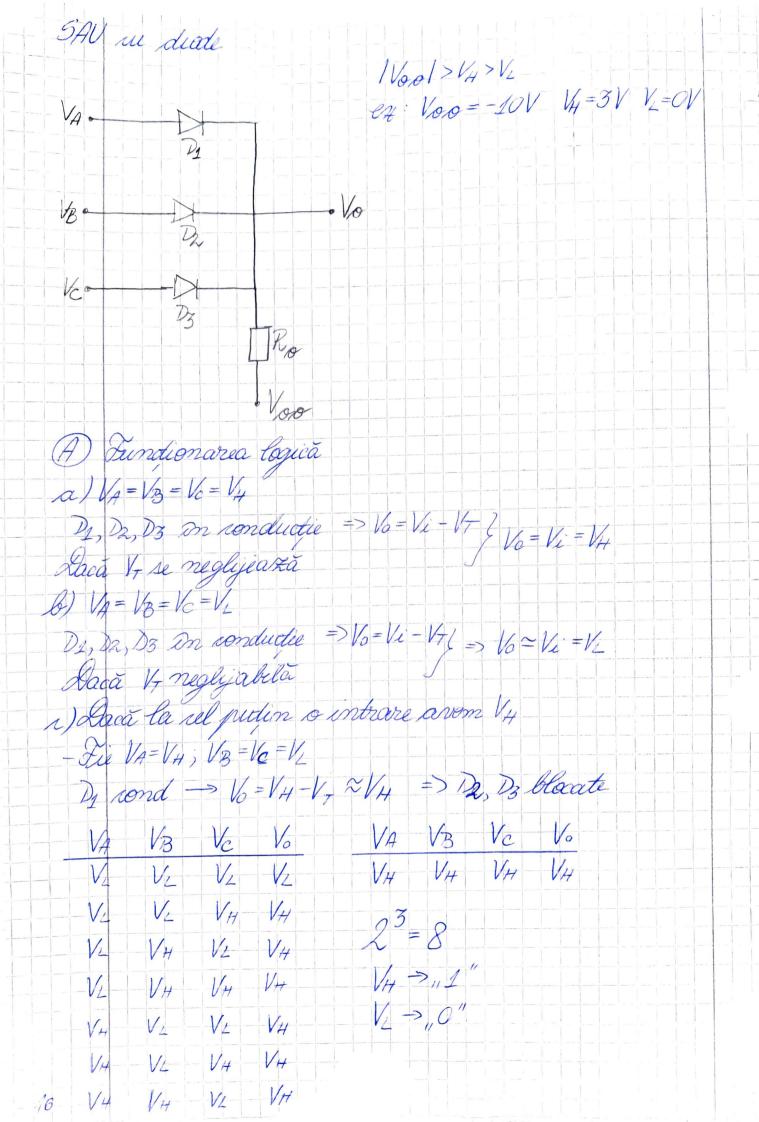
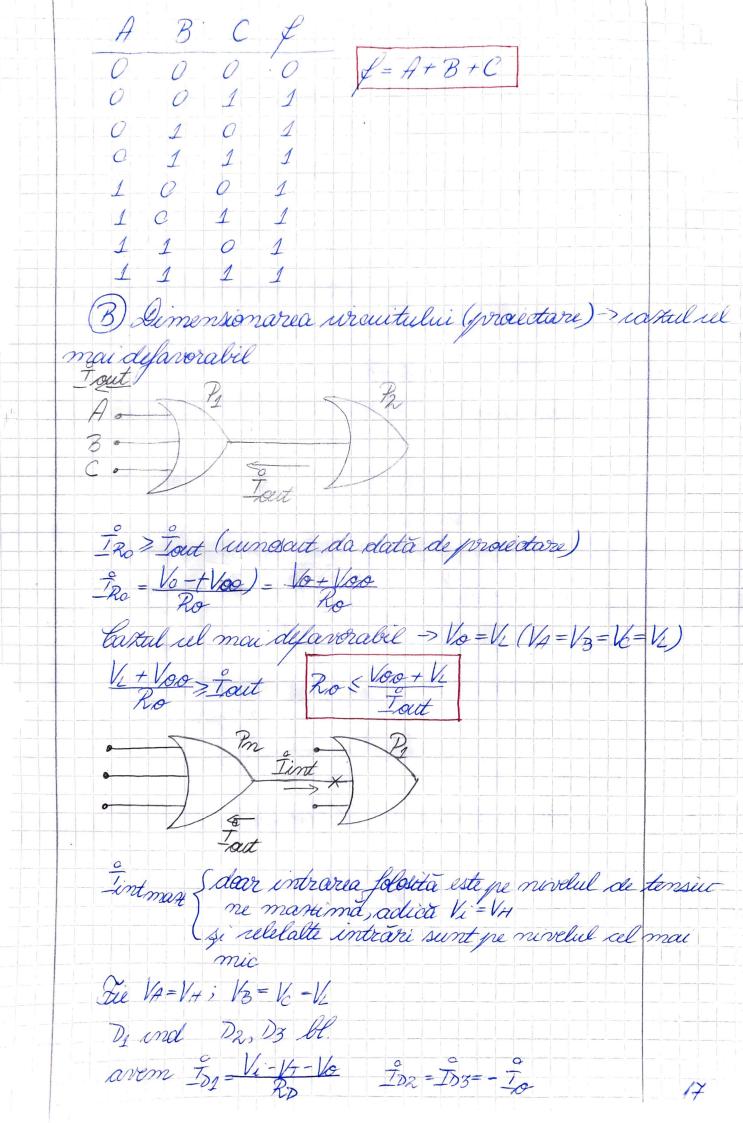


16 = V; {= V4 + V7 Larta 3) introduce o deplasare de novel su tensiunea de prag 4 positivă (mai mare decat Vi) la mpatibilitatea nivelelor de tensiune între intrare silesire Vo = Vi (Vp = VB = Ve = ...) Transistor Tact > Tint Vo = Vi Parametrii dinamici ( timp (f. f. mic) Greenenta (f. f. mare) Vi=(VA=VB=Vc) Cp = Co + Chr + D Ci > capacitate para xeta tr= 6ln VH - G1(VH-VL) VH - G9(VH-VL) tn=6ln V4-0,1·V4 = 6. lng ~ 226 6 = RA. Gr to = RA. Cp. lng V2=01 tc= 6, En V2-39(V4-V2) tr = 61 ln 9, unde 61 = RD Gr tc=2,2. RD. Gr & tr, decarece RA>> RD





Tint may = 
$$\frac{1}{R_0} + (n-1)\frac{1}{L_0} = \frac{1}{R_0} + (n-1)\frac{1}{L_0}$$

Tint may =  $\frac{1}{R_0} + (n-1)\frac{1}{L_0}$ 

$$E = \frac{1}{L_0} + \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_0}$$

Transustoul Lyndar ) fundionare  $\frac{1}{T_{c}} = \frac{1}{I_{co}} + \alpha \cdot \frac{1}{I_{E}}$ α-(0,9-c,99) TE jondiunea / 3 jondiunea. Baxa-substratul din mijla -slab dopat su impuritate - santitate mica de sarcini libere Emitorul - puternic dopat un impuritate - santitate mare de sarcini libere Colectorul - slab dopat au impuritati - antitate mica de sarcini libere a) jondiunea BC polarizare inversa B BC polarixare inversa Ton-surent de solector residual - sarcini minoritare din B - saturat (limitat sa valoare) b) jondiunea BE polarikare directà continut mare de sarceni, majoritatea din e